

## Øving 1

Veiledning: Tirsdag 13. januar  
Innleveringsfrist: Fredag 16. januar

### Oppgave 1: Halleffekt med elektroner og hull

I forelesningene diskuterte vi Halleffekten: Dersom vi plasserer en bit av et materiale i et magnetfelt  $\vec{B} = B_z \hat{z}$  og driver en elektrisk strøm i  $x$ -retningen (med strømtetthet  $j_x$ ), får vi etablert et elektrisk felt  $E_y$  i  $y$ -retningen, det såkalte Hallfeltet. Sammenhengen mellom disse tre størrelsene kunne uttrykkes ved Hallkonstanten  $R_H$ :

$$R_H \equiv \frac{E_y}{j_x B_z} = \frac{1}{nq}$$

der  $n$  er antall mobile ladninger pr volumenhet, og  $q$  er ladningen pr partikkel, dvs  $q = -e$  for elektroner.

Vår utledning tok utgangspunkt i at vi kun hadde *en* type ladningsbærere tilstede i et gitt materiale. Vi skal (på neste forelesning) forsøke å sannsynliggjøre at i noen materialer, fortrinnsvis *halvledere*, vil vi ha *to* typer ladningsbærere tilstede, positivt ladete *hull* og negativt ladete elektroner.

Oppgaven her består etterhvert i å vise at med både hull og elektroner tilstede i materialet generaliseres ovenstående uttrykk for Hallkonstanten til

$$R_H = \frac{E_y}{j_x B_z} = \frac{p\mu_p^2 - n\mu_n^2}{e(p\mu_p + n\mu_n)^2}$$

Her er  $n$  og  $p$  henholdsvis antall elektroner og hull pr volumenhet, mens  $\mu_n$  og  $\mu_p$  er *mobiliteten* for henholdsvis elektroner og hull.

Vi trenger selvsagt å vite hvordan mobiliteten er definert. Som vanlig antar vi at materialet er lineært og isotropt. Linearitet innebærer at partiklenes midlere driftshastighet  $\vec{v}$  er proporsjonal med den drivende kraften  $\vec{F}$ , og dermed også proporsjonal med drivende kraft pr ladningsenhet,  $\vec{f} = \vec{F}/|q|$ . Isotropi innebærer at proporsjonalitetskonstanten er uavhengig av hvilken retning i materialet vi betrakter. (I et krystallinsk materiale vil vi typisk *ikke* ha isotropi, men det ser vi altså bort fra her!) Mobiliteten  $\mu$  defineres nå nettopp ved

$$\vec{v} = \mu \vec{f}$$

Den drivende kraften er i vårt tilfelle Lorentzkraften:

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

slik at

$$\vec{v} = \pm \mu(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

der positivt (negativt) fortegn gjelder for hull (elektroner) med ladning  $q = e$  ( $q = -e$ ). Med denne definisjonen er mobiliteten alltid en *positiv* størrelse.

Det er ingen spesiell grunn til at elektroner og hull skulle oppnå samme driftshastighet for en bestemt verdi av den drivende kraften. Med andre ord, mobiliteten for elektroner og hull er generelt forskjellige:

$$\mu_n \neq \mu_p$$

a) Eksperimentet utføres ved at Hallprøven påtrykkes en spenning, og dermed et elektrisk felt  $E_x$  i  $x$ -retningen. Magnetfeltet  $B_z$  i  $z$ -retningen fører til at ladningsbærerne avbøyes i  $y$ -retningen og etablerer et elektrisk felt  $E_y$  i  $y$ -retningen. Det er med andre ord ingen (netto) bevegelse i  $z$ -retningen, så vi kan skrive

$$\vec{v}_i = v_{ix}\hat{x} + v_{iy}\hat{y} \quad ; \quad i = n, p$$

for driftshastigheten til elektronene ( $i = n$ ) og hullene ( $i = p$ ). Uttrykk de ulike komponentene av driftshastighetene (dvs  $v_{nx}, v_{ny}, v_{px}, v_{py}$ ) ved mobilitetene ( $\mu_n, \mu_p$ ) og feltene ( $E_x, E_y, B_z$ ).

Tips: Anta at driftshastigheter i  $x$ -retningen ikke påvirkes av magnetfeltet. Med andre ord, anta at  $v_{iy}B_z \ll E_x$ .

b) Når driftshastighetene er kjent, kan vi også beregne strømtettheten  $\vec{j}$ :

$$\vec{j} = -ne\vec{v}_n + pe\vec{v}_p = j_x\hat{x} + j_y\hat{y}$$

Ved stasjonære forhold har vi  $j_y = 0$ . Bruk dette til å vise at Hallkonstanten  $R_H$  blir som oppgitt på side 1.

c) På neste forelesning skal vi se at en helt ren, perfekt krystallinsk halvleder (f.eks. Si) vil ha like mange mobile elektroner og hull, dvs  $n = p$ . Vi skal også se at ved å bytte ut en andel av atomene i krystallen med andre typer atomer (såkalte forurensninger), kan vi lage halvledere med i hovedsak elektroner som ladningsbærere, dvs  $n \gg p$ , eventuelt med i hovedsak hull som ladningsbærere, dvs  $p \gg n$ . Dette kalles da henholdsvis  $n$ -type og  $p$ -type halvledere.

Hva blir  $R_H$  for en  $n$ -type og en  $p$ -type halvleder?